# 第1章

# MAIKo TPC

## 1.1 MAIKo TPC とは

Time Projection Chamber (TPC) は荷電粒子のトラックを検出するために広く用いられている検出器である。荷電粒子が TPC の検出ガス中を通過するとき,飛跡の周囲の粒子をイオン化させる。イオン化で発生した電子をドリフト電場 (図 1.1 中 y 軸方向) により読み出し面にドリフトさせることでトラックを検出する。図 1.1 のように TPC の有感領域中で入射粒子と標的粒子を反応させることで,散乱点の周りを有感領域で覆うことができる。そのため,散乱で放出される低エネルギーの荷電粒子を大立体角で検出することができる。このような検出器として MAIKo TPC が開発された。MAIKo TPC の写真を図 1.2 に示す。

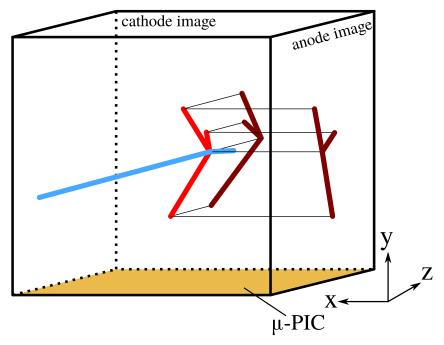


図 1.1: MAIKo TPC の概観図. 図では紙面手前から入射した中性子 (青) が TPC の中の  $^{12}$ C と散乱して  $^{3}$  つの  $^{\alpha}$  粒子 (赤) に崩壊した事象を表す. anode image (zy 平面) と cathode image (zy 平面) の  $^{2}$  平面に荷電粒子のトラックが射影される. 中性子は電荷を持たないため anode & cathode image にトラックとして検出されない.

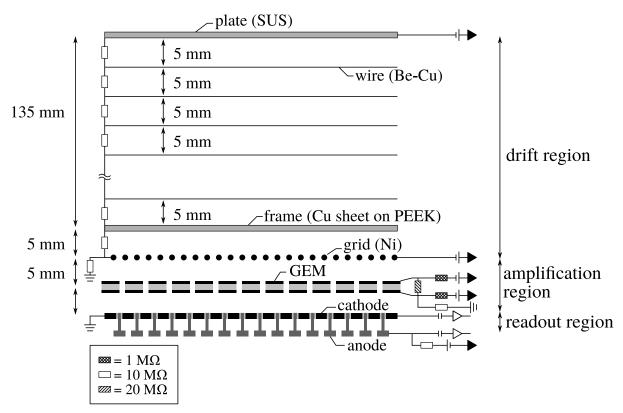


図 1.2: MAIKo TPC の概観.

図 1.3: MAIKo TPC の構造.

#### 1.1.1 MAIKo TPC の構造

図 1.3 に MAIKo TPC の構造を示す。MAIKo TPC は plate, wire, grid, GEM (gas electron multiplier),  $\mu$ -PIC からなる。plate, grid, GEM,  $\mu$ -PIC に HV が接続されている。plate, wire, gird の間は  $10\,\mathrm{M}\Omega$  の 抵抗で繋がれている。GEM と HV は  $1\,\mathrm{M}\Omega$  と  $20\,\mathrm{M}\Omega$  の抵抗で繋がれている。plate から grid の間の領域を ドリフト領域,grid から  $\mu$ -PIC の間の領域を増幅領域, $\mu$ -PIC の周囲を読み出し領域と呼ぶ。

#### 1.1.2 ドリフト領域

grid から plate の方向 (図 1.3 では上向き) にドリフト電場を作ることでトラックの周りに発生した電子を増幅領域へドリフトさせる。ドリフト電場の一様性が高いほど,電子を均等にドリフトすることができる。ドリフト電場を一様に形成するために wire が  $5\,\mathrm{mm}$  間隔で巻かれている [?]。ドリフト領域はドリフト電場の方向に  $140\,\mathrm{mm}$  である。この領域が MAIKo TPC の有感領域となる。

1.1. MAIKO TPC とは 3

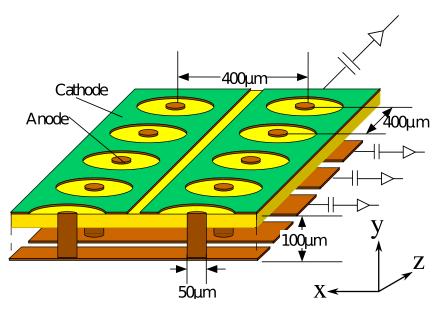


図 1.4: GEM の拡大図.

図 1.5:  $\mu$ -PIC の概観図. 図中の横方向に anode strip, 奥行き方向に cathode strip が配置されている.

#### 1.1.3 増幅領域

MAIKo TPC では GEM と  $\mu$ -PIC を用いて電子の増幅を行う。GEM は,図 1.4 のようにポリマーのフィルムの表面を銅で被覆し,直径  $70~\mu m$  の穴を  $140~\mu m$  間隔で  $1~mm^2$  あたり 100 個の密度で開けたものである。銅の 2 つの層はポリマーによって絶縁されている。銅の両面に電圧を印加することによって,高電場が形成されドリフトしてきた電子が増幅される。  $\mu$ -PIC は図 1.5 のように anode strip と cathode strip が直交するように配置されている。anode strip, cathode strip ともに  $400~\mu m$  間隔でそれぞれ 256 ch 分割されている。直径  $50~\mu m$  の円柱状の anode 電極に高電圧をかけることで高電場を形成することができ, $\mu$ -PIC によって信号が読み出される直前に電子が増幅される。

#### 1.1.4 読み出し領域

図 1.1 中で anode strip は z 軸, cathode strip は x 軸と平行になるように  $\mu$ -PIC が配置されている. ドリフト電場により移動してきた電子を anode strip, cathode strip により読み出し, それぞれ x 軸, z 軸座標を検出することができる. また, anode strip, cathode strip で検出される信号の時間分布により y 軸座標を決定することができる.

MAIKo TPC からは図 1.6 のようにトラックが anode strip に垂直な面 (z-y 平面) に射影された anode image と cathode strip に垂直な面 (z-y 平面) に射影された cathode image の 2 つの画像が出力される. anode strip と cathode strip はそれぞれ 256 ch で構成され,読み出される信号波高の時間変化は 100 MHz で 1,024 samples 測定されるため,出力される画像の解像度は  $256 \times 1,014$  pixels となる.また,anode strip,

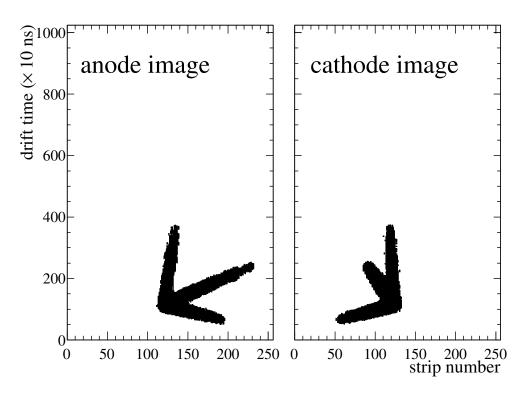


図 1.6: MAIKo TPC から得られず画像データの一例. このイベントは $\ref{Continuous}$ 章で述べるシミュレーションによって生成したデータである.

cathode strip ともに 32 ch ごとにまとめて信号を FADC で波形を取得している. FADC で取得した信号の一例を図 1.7 に示す. FADC では  $25\,\mathrm{MHz}$  で信号波形を取得される.

### 1.2 検出ガスの候補

標的に  $^{12}$ C を用いるため分子中に炭素を含むガスを検出ガスに用いる.  $^{12}$ C 以外の原子核が含まれるガスを用いると背景事象となるため,水素と炭素以外の原子が含まれない炭化水素を用いる。陽子, $^{4}$ He と 14 MeV の中性子の散乱は複数の荷電粒子に崩壊しないため,トラックの本数から背景事象を取り除くことができる。炭化水素の代表的なガスは,メタン ( $^{C}$ CH4) やエタン ( $^{C}$ 2H6),イソブタン ( $^{C}$ 3co- $^{C}$ 4H10) である。また,水素ガスやヘリウムガスとの混合ガスも用いることができる。検出ガスとして求められる性能には以下のようなものがある。

- 放電しにくい
- $\bullet$  荷電粒子のエネルギー損失 (dE/dx) が適切である
- ¹²C の量が少なくない
- 適切なドリフト速度を達成できる
- 適切なドリフト電場のもとでディフュージョンが小さい

これらの項目を基準に検出ガスの種類と圧力の決定を行う.

1.2. 検出ガスの候補 5

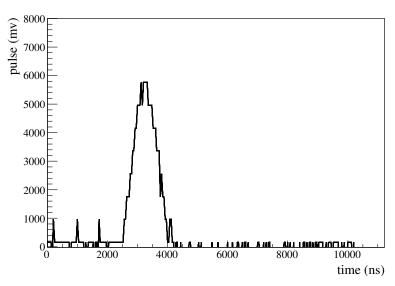


図 1.7: FADC で取得された  $\mu$ -PIC の信号波形の一例.

表 1.1:  $50 \, \text{hPa}$  のときの  $\text{CH}_4$  のパラメータ.

項目	値
密度	$3.29 \times 10^{-5}  \mathrm{g/cm^3}$
$dE/dx~(E_{\alpha}=0.5\mathrm{MeV},~10\mathrm{mm})$	$0.107\mathrm{MeV}$
飛距離 $(E_{\alpha} = 0.5 \mathrm{MeV})$	$65.6\mathrm{mm}$

#### 1.2.1 エネルギー損失

荷電粒子のエネルギー損失 (dE/dx) が大きくなりすぎるとガス中での飛行距離が短くなり,トラックとして認識することが難しくなる。本実験では荷電粒子のエネルギーをトラックの長さから決定する。そのため,dE/dx が小さくなりすぎるとトラックが有感領域で止まらず,トラックの長さ (エネルギー) を決定することができなくなる。検出する対象である  $\alpha$  粒子の dE/dx が適切な大きさとなるガスの種類と圧力の候補を選出する。

まず、代表的な炭化水素である  $CH_4$  を考える。ガス中で  $15\,\mathrm{mm}$  以上飛行し、MAIKo TPC の有感領域中で停止する  $\alpha$  粒子を検出可能な  $\alpha$  粒子と定義する。図??に示したエネルギー分布の  $\alpha$  粒子のうち、検出できた割合の圧力依存性を図 1.8 に示す。このとき、散乱点がビーム軸上に一様に分布しているとして計算した。図 1.8 から分かるように、 $50\,\mathrm{hPa}$  で最大となっている。 $50\,\mathrm{hPa}$  のときの  $CH_4$  の各種の値は表 1.1 のとおりである。

 $50\,\mathrm{hPa}$  のときの  $\mathrm{CH_4}$  の dE/dx と同程度となる,他のガスを考えていく.表 1.2 に示した 6 つを候補とした.混合ガスでは圧力を  $100\,\mathrm{hPa}$  に固定し混合比をパラメータとして dE/dx を合わせる.括弧内はガスの混合の割合を示す.これらの 6 種類の候補から検出ガスを選ぶ.

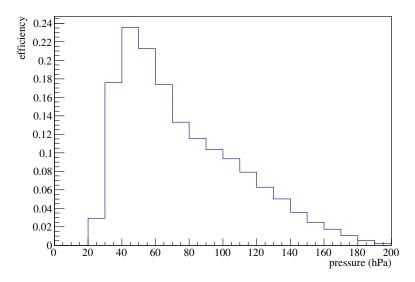


図 1.8:  $\mathrm{CH_4}$  の圧力による検出効率の分布.  $\alpha$  粒子は図??に示したエネルギー分布を仮定した.

表 1.2: ガスの混合パターン,月	圧力, $dE/dx$ .	括弧内はガスの混合の割合を示す.
--------------------	---------------	------------------

gas	pressure (hPa)	density $(g/cm^3)$	$dE/dx \; ({ m MeV})$ $E_{lpha} = 0.5  { m MeV}$ $10  { m mm}$	ドリフト電場 (V/mm) @ 0.014 mm/ns
$ m CH_4$	50	$3.29 \times 10^{-5}$	0.107	0.418
$CH_4(3) + H_2(7)$	100	$2.55{\times}10^{-5}$	0.107	4.31
$CH_4(4) + He(6)$	100	$3.62{ imes}10^{-5}$	0.109	1.89
$iso-C_4H_{10}$	15	$3.58{\times}10^{-5}$	0.102	0.644
iso- $C_4H_{10}$ (1) + $H_2$ (9)	100	$3.13{ imes}10^{-5}$	0.122	6.80
iso- $C_4H_{10}$ (1) + He (9)	100	$3.86{\times}10^{-5}$	0.102	3.26

#### 1.2.2 ドリフトスピード

MAIKo TPC では  $100\,\mathrm{MHz}$  で  $1024\,\mathrm{samples}$  データを取得するため,ドリフト方向は  $10.24\,\mathrm{µs}$  のタイム ウィンドウが開いている.ドリフトケージの大きさ  $(140\,\mathrm{mm})$  を可能な限りタイムウィンドウに収めるために は, $\mathrm{µs}$  ドリフトスピードを  $140\,\mathrm{mm}/10.24\,\mathrm{µs}\sim0.014\,\mathrm{mm/ns}$  に調整する必要がある.Magboltz [?] によって計算したドリフト電場とドリフトスピードの関係を図??に,ドリフトスピードが  $0.014\,\mathrm{mm/ns}$  となるドリフト電場の値を表 1.2 に示す.図??の横方向の点線は  $0.014\,\mathrm{mm/ns}$  を表す.以降,これらのドリフト電場で評価を行う.

 1.2. 検出ガスの候補
 7

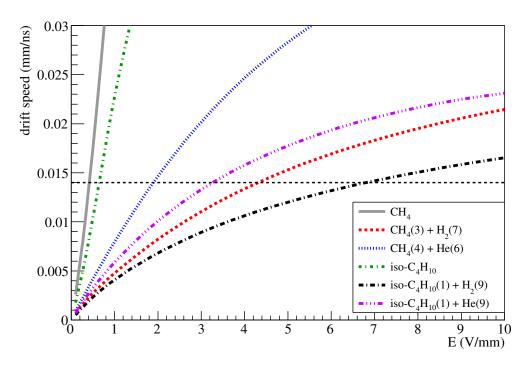


図 1.9: ドリフト電場とドリフトスピードの関係.  $CH_4$  は  $50\,hPa$ , iso- $C_4H_{10}$  は  $15\,hPa$ , その他は  $100\,hPa$  である. 横方向の点線は  $0.014\,mm/ns$  を示す.

### 1.2.3 ディフュージョン

ドリフト電場によって電子が移動する間に検出ガスとの散乱と電子の熱運動により、図??のように広がりながらドリフトする。電子が広がることをディフュージョンと呼ぶ。この効果が大きくなると、荷電粒子によって同じ場所に生成された電子が $\mu$ -PIC に到達するまでに広がるため、トラックが太く検出される。トラックが太くなると、複数のトラックを分離することが難しくなる。そのため、ディフュージョンの効果が小さいことが望まれる。

ドリフト電場がない場合のディフュージョンは以下のように理解できる。電子は熱運動により発生点から拡散する。熱運動の平均速度 v は Maxwell 分布により

$$v = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}} \tag{1.1}$$

と表せる。ここで  $k_B$  はボルツマン定数,T は温度,m は粒子の質量である。電子が発生した時刻から  $\Delta t$  後では,

$$\frac{N_0}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \tag{1.2}$$

のガウス分布で電子が広がる.ここで  $N_0$  は全粒子数,x は発生した点からの距離,D はディフュージョン係数を表す.ディフュージョン係数 D は電子の平均自由工程  $\lambda$  を用いて

$$D = \frac{1}{3}v\lambda \tag{1.3}$$

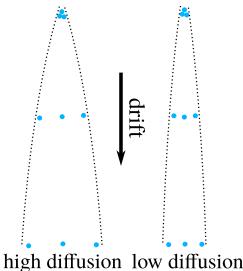


図 1.10: ディフュージョンによって電子が拡散するイメージ. 同じ位置で生成された 電子でもドリフトする間に位置が拡散する.

と表せる. 理想気体において平均自由工程  $\lambda$  は、ガスとの散乱の全断面積  $\sigma_0$ 、圧力 p のもとで

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{k_B T}{\sigma_0 p} \tag{1.4}$$

と表される. 式??, ??, ??により,

$$D = \frac{2}{3\sqrt{\pi}} \frac{1}{p\sigma_0} \sqrt{\frac{\left(k_B T\right)^3}{m}} \tag{1.5}$$

となる.式??より、同じガスでは圧力が高いほど、温度が低いほどディフュージョン係数が小さいことが分 かる.

ドリフト電場がある場合、発生点からの距離をL、ドリフトスピードを $drift_v$ とすると、

$$\Delta t = \frac{L}{drift_{-}v} \tag{1.6}$$

となる. 直感的には, 式??の分散  $\sigma(L)$  は

$$\sigma(L) = \sqrt{2D\Delta t} \tag{1.7}$$

$$= \sqrt{\frac{2D}{drift_{-}v}} \times \sqrt{L} \tag{1.8}$$

$$= D_{\text{Magboltz}} \times \sqrt{L} \tag{1.9}$$

となる. Magboltz によってディフュージョン係数  $D_{ ext{Magboltz}}$  が得られる. Magboltz によって計算したディ フュージョン係数を表 $\ref{eq:total_condition}$ に示す。表 $\ref{eq:total_condition}$ ではドリフト方向に対して垂直な方向への拡散, $D_l$  は電子の運 動方向への拡散の係数を表す. $\mathrm{CH_4}$  および  $\mathrm{iso} ext{-}\mathrm{C_4H_{10}}$  の単体ではディフージョン係数が大きく,同じドリフ トスピードのとき、ドリフト電場が大きいほどディフュージョン係数が小さいことが分かる.

 $iso-C_4H_{10}$  (1)  $+H_2$  (9) が最もディフュージョン係数が小さく、検出ガスの最有力候補である。シミュレー ションにより生成した  $^{12}\mathrm{C}(\mathbf{n},\mathbf{n}')^{12}\mathrm{C}^{\mathrm{Hoyle}}$  イベントを解析し、その解析効率により検出ガスを決定する.

1.2. 検出ガスの候補 9

表 1.3: Magboltz で計算したディフュージョンの係数. ディフージョンの大きさはドリフト電場に依存するため,ここではドリフトスピードが  $0.014~\mathrm{mm/ns}$  になるドリフト電場での値を示す.  $D_t$ ,  $D_l$  はそれぞれ運動方向に垂直,平行方向のディフュージョン.

gas	$D_t \ (\sqrt{\mathrm{mm}})$	$D_l$ ( $\sqrt{\mathrm{mm}}$ )	ドリフト電場 (V/mm)
$\mathrm{CH}_4$	0.433	0.547	0.418
$CH_4(3) + H_2(7)$	0.214	0.171	4.31
$CH_4(4) + He(6)$	0.270	0.248	1.89
iso- $C_4H_{10}$	0.357	0.414	0.644
iso- $C_4H_{10}(1) + H_2(9)$	0.196	0.145	6.80
iso- $C_4H_{10}$ (1) + He (9)	0.246	0.197	3.26